# Magnetic recording disk.

Patent Number:

EP0109481, A3, B1

Publication date:

1984-05-30

Inventor(s):

**WEISS JOEL RICHARD** 

Applicant(s):

IBM (US)

Requested Patent:

JP59096539

Application Number: EP19830105929 19830616

Priority Number(s): IPC Classification:

US19820443515 19821122 G11B5/64; G11B5/82

EC Classification:

G11B5/64, G11B5/72

Equivalents:

DE3375340D, JP1614291C, JP2041089B

Cited Documents:

GB2096647; EP0054640; JP58077027; JP57071518; JP57183633

#### Abstract

A magnetic recording disk is formed with a silicon substrate, the surfaces of which are essentially free of asperities. A non-magnetic undercoat layer is coated on one or both surfaces of the substrate. A magnetic layer is applied to the free surface of the or each undercoat layer. A non-magnetic overcoat layer is applied to the or each magnetic layer.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

69日本国特許庁(JP)

(11) 特許出願公告

#### $\Psi 2 - 41089$ 許 公 報(B2) ⑫特

®Int.Cl.5

مد نی

識別記号

庁内整理番号

2040公告 平成2年(1990)9月14日

G 11 B 5/82 7350-5D

発明の数 1 (全2頁)

磁気配録デイスク 60発明の名称

JP-A 59-96539

到特 顧 昭58-123548

開 昭59-96539 多公

願 昭58(1983)7月8日 ❷出

@昭59(1984)6月4日

❷1982年11月22日❷米国(US)❸443515 優先権主張

20発明者 ジョエル・リチヤー アメリカ合衆国カリフオルニア州モーガン・ヒル・コパ

ー・ヒル・ドライブ17065番地

インターナショナル の出 願 人

アメリカ合衆国 10504 ニューヨーク州 アーモンク

ビジネス マシーンズ (番地なし)

コーポレーション

外1名 70代 理 人 弁理士 山本 仁朗

ド・ウエイス

審査官 相馬 多美子

**多参考文献** 特開 昭57-105826(JP,A) 特開 昭59-8141 (JP, A)

1

#### ②特許請求の範囲

1 表面上に実質上凹凸のないシリコン基板と、 該シリコン基板上にスパツタされた非磁性の下地 層と、該下地層上にスパツタされた磁性層と、該 気配録デイスク。

2 上記非磁性の下地層がCrである事を特徴と する特許請求の範囲第1項記載の磁気記録デイス 2.

### 発明の詳細な説明

本発明は一般的に磁気記録デイスクに関し、さ らに具体的にはシリコン基板を使用して形成され たこの様なデイスクに関する。

#### 〔従来技術の説明〕

磁気記録において、アルミニウム基板上に微粒 15 体の重量を著しく重くする。 子もしくは薄膜磁気被膜を有するデイスクの使用 は周知である。この様な型の被膜の各々は、特に 現在及び将来使用される高ピット密度記録パター ンのために必要とされる極めて薄い被膜の場合に う問題を有する。

アルミニウム基板上の微粒子磁気被膜は、特に 極めて薄い場合に、デイスクに関連する磁気変換 2

器との接触によって耐用性が限られる。アルミニ ウム基板上に磁気被膜をスパツタリング蒸着もし くは電着する事によつて通常形成される薄膜磁気 デイスクは一般に微粒子被膜の場合よりも薄い磁 磁性層上に設けられた非磁性保護層とより成る磁 5 気被膜を与える。しかしながら、薄膜デイスクは 主に重量と付着される薄膜層のためにアルミニウ ムである事が要求される金属基板との反応によつ て著しい腐食をしばしば生ずる。この様なディス クは基板と薄膜磁性層間及び薄膜磁性層上に2万 10 至それ以上の保護層の付着を必要とする。明らか に、この様な保護層は薄膜デイスクのコストを著 しく高くする。さらに微粒子及び薄膜磁気デイス クは通常被膜の厚さと比較して実實上厚い基板を 使用し、この様なデイスクのいくつかを含む組立

金属もしくは重合体の薄膜は基板の表面の形状 をなぞらえるのでアルミニウム基板における表面 の完全性(即ち振幅の変調及びヘッドの衝突を防 止するための表面荒さ、平坦度等)を達成するた は、被膜を完全に満足のいかないものにするとい 20 めの試みがこれ迄になされて来た。基板の研摩及 び被覆方法の改善がなされて来たが、将来の主た るパホーマンスの改善も基板表面の完全性の増強 に依存する。

3

特願昭56-137895号(特開昭57-105826号) は、磁気配録デイスク基板としてシリコンを用い る構造を開示しているが、これはシリコン基板を 支持する強化コア部材を必要としている。

# 〔本発明の概要〕

本発明に従い、磁気記録デイスクは先ずシリコ ン上に或る材料の層を付着する事によってシリコ ン基板上に形成され、これによって磁気的パホー マンス及びその後に付着される磁性層の付着力が れる。強化コア部材は本発明にとつて必要とされ ない。

## (実施例の説明)

本発明に従い、シリコン基板は半導体市場で容 易に利用可能な通常のシリコン板を切断する事に 15 見されている。 よつて形成され得る。基板は任意の適切な技法に よつてシリコン板からスライスされ得る。この様 なシリコン板は15.24cmよりも大きな直径のもの が利用可能である。基板ウェフアは0.043万至 が研摩され得る。これ等のシリコン基板の表面は 特に平坦で凹凸がない事が知られている。 シリコ ン基板に被膜を付着する前に、回転させるための 適切な構造体に対して仕上つた磁気記録デイスク をクランプさせるための中央開孔がシリコン基板 25 に与えられる事が好ましい。この開孔は例えばレ ーザ切断もしくはダイアモンド・コア穿孔によつ て発生され得る。シリコン基板が先ず形成された 後、基板の両表面にRFスパツタリングによって の厚さに昇華/蒸着されるCrである事が好まし い。このシリコン表面上の下地層の付着は上層の 磁性層の磁性を増強するが、AlMgの如きシリコ

ン以外の基板上の下地層としてCrが同様に付着 させられる時は、磁性の増強は生じない事が発見 された。

下地層の付着に続いて、磁性層が再びRFスパ 5 ツタリングによつて付着させられる。この磁性層 は米国特許第4245008号に説明されたFe、Co、 Cr磁性層の如き適切な型のものであり得る。こ の特許に開示されている如く、磁性層は重量%で 0 乃至55%のCo、 8 乃至22%のCr、及び残部の 増強される。磁性層には薄い保護層が付着させら 10 主にFeより成る。この様な磁性層はRFスパッタ リングによつて略300人の厚さに付着させられる。 上記の如く形成された磁性薄膜は300乃至1000

エルステッドの範囲の保磁力及び略90%以上の磁 機方形比の如き優れた磁気的性質を有する事が発

上述の米国特許第4245008号に開示されたF、 Co、Cr磁性層に代つて、他の磁性層を使用する こともできる。例えばFesO4の層がRFスパツタ され、付着位置での酸化によって磁性Fe2O3にさ 0.081cmの範囲の適当な厚さに切断され、両表面 20 れる。適切な上層がこの磁性層を保護するために 与えられる。この様な上層は磁性層の磁気的特性 をを劣化させない様に十分薄く、硬くて耐久性の あるセラミツク、重合体もしくは金属薄膜であり 得る。

> 1つの特に魅力的な保護層は沈殿/浸漬プロセ スによつて付着させられる直径70人のSiOzピー ズ及び50Å乃至100ÅのアモルフアスSiOsの単一 層によつて形成され得る事が発見された。

もし望まれるならば、変換器とディスク表面間 下地層が付着させられる。この下地層は略4500人 30 に有害な接触を与える事なく、回転するデイスク 表面に関して狭い空気ベアリングをはさんで変換 器が容易に浮遊する様に保護上層の表面には潤滑 剤が与えられ得る。